**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования
_____ П.Е. Троян
«19» _____12_____ 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

# ТЕХНОЛОГИЯ КРЕМНИЕВОЙ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**
Направление подготовки / специальность: **11.03.04 Электроника и наноэлектроника**
Направленность (профиль) / специализация: **Микроэлектроника и твердотельная электроника**
Форма обучения: **очная**
Факультет: **Факультет электронной техники (ФЭТ)**
Кафедра: **Кафедра физической электроники (ФЭ)**
Курс: **4**
Семестр: **7**
Учебный план набора 2019 года

Объем дисциплины и виды учебной деятельности

| Виды учебной деятельности | 7 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 26 | 26 | часов |
| Практические занятия | 18 | 18 | часов |
| Лабораторные занятия | 16 | 16 | часов |
| Самостоятельная работа | 48 | 48 | часов |
| Подготовка и сдача экзамена | 36 | 36 | часов |
| Общая трудоемкость (включая промежуточную аттестацию) | 144 | 144 | часов |
| | 4 | 4 | з.е. |

| Формы промежуточной аттестация | Семестр |
|---|---|
| Экзамен | 7 |

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шелупанов А.А.
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.12.2018
Уникальный программный ключ:
c53e145e-8b20-45aa-9347-a5e4dbb90e8d

Томск

Согласована на портале № 60083

## 1. Общие положения

### 1.1. Цели дисциплины

1. освоение студентами комплекса теоретических и практических знаний в области перспективных технологических процессов, которые позволяют увеличить степень интеграции схем, и позволяют создавать сверхбольшие интегральные схемы для кремниевой наноэлектроники.

### 1.2. Задачи дисциплины

1. формирование знаний в области нанотехнологий кремниевой наноэлектроники.
2. изучение базовых технологических процессов производства СБИС для кремниевой наноэлектроники.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Индекс дисциплины: Б1.В.16.
Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

## 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):
Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

| Компетенция | Индикаторы достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
|---|---|---|
| **Универсальные компетенции** | | |
| - | - | - |
| **Общепрофессиональные компетенции** | | |
| - | - | - |
| **Профессиональные компетенции** | | |
| ПКР-7. Способен выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники | ПКР-7.1. Знает технологические основы производства материалов и изделий электронной техники | знает физико-химические основы базовых технологических процессов производства кремниевых ИС;<br>знает базовые маршруты изготовления кремниевых интегральных схем;<br>знает принципы разработки технологических маршрутов производства кремниевых ИС |
| | ПКР-7.2. Умеет выполнять отдельные технологические операции по производству материалов и изделий электронной техники | умеет разрабатывать технологические маршруты изготовления кремниевых ИС;<br>умеет выбирать параметры технологических операций |
| | ПКР-7.3. Владеет навыками построения технологических маршрутов изготовления материалов и изделий электронной техники | владеет навыками разработки базовых технологических процессов |

Согласована на портале № 60083

| | | |
|---|---|---|
| ПКР-8. Способен организовывать метрологического обеспечение производства материалов и изделий электронной техники | ПКР-8.1. Знает основные стандарты по метрологическому обеспечению изделий электронной техники | знает физико-химические основы базовых технологических процессов производства кремниевых ИС;<br>знает базовые маршруты изготовления кремниевых интегральных схем;<br>знает принципы разработки технологических маршрутов производства кремниевых ИС |
| | ПКР-8.2. Умеет проводить измерения в соответствии со стандартами | умеет разрабатывать технологические маршруты изготовления кремниевых ИС;<br>умеет выбирать параметры технологических операций |
| | ПКР-8.3. Владеет навыками работы на стандартном измерительном оборудовании | владеет навыками разработки базовых технологических процессов |
| ПКС-2. Способен к применению современных технологических процессов и технологического оборудования на этапах разработки и производства изделий микроэлектроники и твердотельной электроники | ПКС-2.1. Знает основное технологическое оборудование для производства изделий электронной техники | знает физико-химические основы базовых технологических процессов производства кремниевых ИС;<br>знает базовые маршруты изготовления кремниевых интегральных схем;<br>знает принципы разработки технологических маршрутов производства кремниевых ИС |
| | ПКС-2.2. Умеет обосновывать выбор технологического процесса и оборудования для его реализации | умеет разрабатывать технологические маршруты изготовления кремниевых ИС;<br>умеет выбирать параметры технологических операций |
| | ПКС-2.3. Владеет навыками практической работы на технологическом оборудовании | владеет навыками разработки базовых технологических процессов |

## 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

| Виды учебной деятельности | Всего часов | Семестры |
|---|---|---|
| | | 7 семестр |
| **Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего** | 60 | 60 |
| Лекционные занятия | 26 | 26 |
| Практические занятия | 18 | 18 |
| Лабораторные занятия | 16 | 16 |
| **Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего** | 48 | 48 |
| Подготовка к контрольной работе | 7 | 7 |

Согласована на портале № 60083

| | | |
|---|---|---|
| Подготовка к тестированию | 7 | 7 |
| Написание отчета по практическому занятию (семинару) | 18 | 18 |
| Подготовка к лабораторной работе, написание отчета | 16 | 16 |
| **Подготовка и сдача экзамена** | 36 | 36 |
| **Общая трудоемкость (в часах)** | 144 | 144 |
| **Общая трудоемкость (в з.е.)** | 4 | 4 |

## 5. Структура и содержание дисциплины

### 5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

| Названия разделов (тем) дисциплины | Лек. зан., ч | Прак. зан., ч | Лаб. раб. | Сам. раб., ч | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 семестр** | | | | | | |
| 1 Тенденция развития современной кремниевой технологии микро- и наноэлектроники | 1 | - | - | 2 | 3 | ПКР-7, ПКС-2 |
| 2 Субмикронная фотолитография | 2 | 2 | - | 4 | 8 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| 3 Пучковые методы литографии | 6 | 6 | - | 8 | 20 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| 4 Ионное легирование полупроводников | 6 | 6 | - | 8 | 20 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| 5 Ионное и плазмохимическое травление микро- и наноструктур | 5 | 2 | 4 | 8 | 19 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| 6 Осаждение металлов и диэлектриков. Планаризация рельефа | 4 | - | 4 | 6 | 14 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| 7 Технологические маршруты изготовления кремниевых ИС | 2 | 2 | 8 | 12 | 24 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| Итого за семестр | 26 | 18 | 16 | 48 | 108 | |
| Итого | 26 | 18 | 16 | 48 | 108 | |

### 5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)

| Названия разделов (тем) дисциплины | Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) | Трудоемкость (лекционные занятия), ч | Формируемые компетенции |
|---|---|---|---|
| **7 семестр** | | | |
| 1 Тенденция развития современной кремниевой технологии микро- и наноэлектроники | Международная технологическая дорожная карта для полупроводникового производства. Закон Мура. | 1 | ПКР-7, ПКС-2 |
| | Итого | 1 | |

Согласована на портале № 60083

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 Субмикронная фотолитография | Основные понятия и тенденции. Иммерсионная литография КУФ диапазона. Литография ЭУФ диапазона. Импринтинг | 2 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 2 | |
| 3 Пучковые методы литографии | Электронно-лучевые установки. Параметры установок. Расчеты диаметра сфокусированного луча. Рассеяние пучка электронов в резисте. Время экспонирования. Разрешающая способность электронно-лучевой литографии. Ионная литография. Рентгенолитография | 6 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 6 | |
| 4 Ионное легирование полупроводников | Технология ионного легирования. Пробеги ионов в аморфных веществах. Профили распределения концентрации внедренных ионов в аморфных и монокристаллических мишенях. Радиационные дефекты при ионном легировании. Отжиг дефектов. Быстрый термический отжиг. Новые методы импульсного отжига. Области применения ионного легирования. | 6 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 6 | |
| 5 Ионное и плазмохимическое травление микро- и наноструктур | Классификация процессов. Основные параметры травления. Физика ионного травления. Разрешающая способность ионно-лучевого травления. Плазмохимическое травление (ПХТ). Модель и методы ПХТ | 5 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 5 | |
| 6 Осаждение металлов и диэлектриков. Планаризация рельефа | Атомно-слоевое осаждение из газовой фазы. Ионное и ионно-плазменное осаждение тонких слоев диоксида кремния, нитрида кремния, нитрида алюминия, кремния и металлов. Ионно-стимулированное, ионно-лучевое напыление тонких пленок. Основные понятия и тенденции развития. Технология химико-механической планаризации | 4 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 4 | |
| 7 Технологические маршруты изготовления кремниевых ИС | Основные понятия и тенденции развития. Инженерия межуровневого диэлектрика и межуровневой разводки. Технологический маршрут | 2 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 2 | |
| Итого за семестр | | 26 | |
| Итого | | 26 | |

Согласована на портале № 60083

### 5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Наименование практических занятий (семинаров)

| Названия разделов (тем) дисциплины | Наименование практических занятий (семинаров) | Трудоемкость, ч | Формируемые компетенции |
|---|---|---|---|
| **7 семестр** | | | |
| 2 Субмикронная фотолитография | Субмикронная фотолитография | 2 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 2 | |
| 3 Пучковые методы литографии | Электронно-лучевая литография | 6 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 6 | |
| 4 Ионное легирование полупроводников | Ионная имплантация в технологии СБИС | 6 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 6 | |
| 5 Ионное и плазмохимическое травление микро- и наноструктур | Ионно-лучевое травление микро- и наноструктур | 2 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 2 | |
| 7 Технологические маршруты изготовления кремниевых ИС | Маршрут изготовления СБИС | 2 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 2 | |
| Итого за семестр | | 18 | |
| Итого | | 18 | |

### 5.4. Лабораторные занятия

Наименование лабораторных работ приведено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Наименование лабораторных работ

| Названия разделов (тем) дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость, ч | Формируемые компетенции |
|---|---|---|---|
| **7 семестр** | | | |
| 5 Ионное и плазмохимическое травление микро- и наноструктур | Исследование процессов травления микро- и наноструктур | 4 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 4 | |
| 6 Осаждение металлов и диэлектриков. Планаризация рельефа | Исследование межэлементной щелевой изоляции в кремниевой наноэлектронике | 4 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 4 | |
| 7 Технологические маршруты изготовления кремниевых ИС | Исследование процессов формирования Т-образного затвора p-HEMT транзистора | 4 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Методы формирования микро- и наноструктур | 4 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 |
| | Итого | 8 | |
| Итого за семестр | | 16 | |
| Итого | | 16 | |

### 5.5. Курсовой проект / курсовая работа

Согласована на портале № 60083

Не предусмотрено учебным планом

### 5.6. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

| Названия разделов (тем) дисциплины | Виды самостоятельной работы | Трудоемкость, ч | Формируемые компетенции | Формы контроля |
|---|---|---|---|---|
| **7 семестр** | | | | |
| 1 Тенденция развития современной кремниевой технологии микро- и наноэлектроники | Подготовка к контрольной работе | 1 | ПКР-7, ПКС-2 | Контрольная работа |
| | Подготовка к тестированию | 1 | ПКР-7, ПКС-2 | Тестирование |
| | Итого | 2 | | |
| 2 Субмикронная фотолитография | Подготовка к контрольной работе | 1 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Контрольная работа |
| | Подготовка к тестированию | 1 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Тестирование |
| | Написание отчета по практическому занятию (семинару) | 2 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Отчет по практическому занятию (семинару) |
| | Итого | 4 | | |
| 3 Пучковые методы литографии | Подготовка к контрольной работе | 1 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Контрольная работа |
| | Подготовка к тестированию | 1 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Тестирование |
| | Написание отчета по практическому занятию (семинару) | 6 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Отчет по практическому занятию (семинару) |
| | Итого | 8 | | |
| 4 Ионное легирование полупроводников | Подготовка к контрольной работе | 1 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Контрольная работа |
| | Подготовка к тестированию | 1 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Тестирование |
| | Написание отчета по практическому занятию (семинару) | 6 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Отчет по практическому занятию (семинару) |
| | Итого | 8 | | |

Согласована на портале № 60083

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Ионное и плазмохимическое травление микро- и наноструктур | Подготовка к контрольной работе | 1 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Контрольная работа |
| | Подготовка к лабораторной работе, написание отчета | 4 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Лабораторная работа |
| | Подготовка к тестированию | 1 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Тестирование |
| | Написание отчета по практическому занятию (семинару) | 2 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Отчет по практическому занятию (семинару) |
| | Итого | 8 | | |
| 6 Осаждение металлов и диэлектриков. Планаризация рельефа | Подготовка к контрольной работе | 1 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Контрольная работа |
| | Подготовка к лабораторной работе, написание отчета | 4 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Лабораторная работа |
| | Подготовка к тестированию | 1 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Тестирование |
| | Итого | 6 | | |
| 7 Технологические маршруты изготовления кремниевых ИС | Подготовка к контрольной работе | 1 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Контрольная работа |
| | Подготовка к лабораторной работе, написание отчета | 8 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Лабораторная работа |
| | Подготовка к тестированию | 1 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Тестирование |
| | Написание отчета по практическому занятию (семинару) | 2 | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Отчет по практическому занятию (семинару) |
| | Итого | 12 | | |
| Итого за семестр | | 48 | | |
| | Подготовка и сдача экзамена | 36 | | Экзамен |
| Итого | | 84 | | |

### 5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности представлено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

| Формируемые компетенции | Виды учебной деятельности | | | | Формы контроля |
|---|---|---|---|---|---|
| | Лек. зан. | Прак. зан. | Лаб. раб. | Сам. раб. | |
| ПКР-7 | + | + | + | + | Контрольная работа, Лабораторная работа, Тестирование, Экзамен, Отчет по практическому занятию (семинару) |

Согласована на портале № 60083

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПКР-8 | + | + | + | + | Контрольная работа, Лабораторная работа, Тестирование, Экзамен, Отчет по практическому занятию (семинару) |
| ПКС-2 | + | + | + | + | Контрольная работа, Лабораторная работа, Тестирование, Экзамен, Отчет по практическому занятию (семинару) |

## 6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

### 6.1. Балльные оценки для форм контроля

Балльные оценки для форм контроля представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Балльные оценки

| Формы контроля | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
|---|---|---|---|---|
| **7 семестр** | | | | |
| Контрольная работа | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Лабораторная работа | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Тестирование | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Отчет по практическому занятию (семинару) | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Экзамен | | | | 30 |
| Итого максимум за период | 15 | 15 | 40 | 100 |
| Нарастающим итогом | 15 | 30 | 70 | 100 |

### 6.2. Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Пересчет баллов в оценки за текущий контроль представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

| Баллы на дату текущего контроля | Оценка |
|---|---|
| ≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату ТК | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату ТК | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату ТК | 3 |
| < 60% от максимальной суммы баллов на дату ТК | 2 |

### 6.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка | Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен | Оценка (ECTS) |
|---|---|---|
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 – 100 | A (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | B (очень хорошо) |
| | 75 – 84 | C (хорошо) |
| | 70 – 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 | |
| | 60 – 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Согласована на портале № 60083

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 7.1. Основная литература

1. Технология кремниевой наноэлектроники [Текст] : учебное пособие / Т. И. Данилина, В. А. Кагадей, Е. В. Анищенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. - 2-е изд. - Томск : ТУСУР, 2015. - 319 с : рис., цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 317-318. - ISBN 978-5-86889-713-9 (наличие в библиотеке ТУСУР - 29 экз.).
2. Технология СБИС: учебное пособие / Т.И.Данилина, В.А.Кагадей , Федеральное агентство по образованию, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Кафедра физической электроники. - Томск : ТУСУР, 2007. - 287 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 48 экз.).
3. Процессы микро- и нанотехнологии : учебное пособие для вузов / Т. И. Данилина [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томск). - Томск : ТУСУР, 2005. - 316 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 99 экз.).
4. Технология кремниевой наноэлектроники [Текст] : учебное пособие / Т. И. Данилина, В. А. Кагадей, Е. В. Анищенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. - 2-е изд. - Томск : ТУСУР, 2015. - 319 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://miel.tusur.ru/dwn/umo/id/145a80d7f299/f/TKH_Danilina_Uchebnoe_posobie.pdf.

### 7.2. Дополнительная литература

1. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем: учебное пособие для вузов: в 2 ч. / Под ред. Ю.А. Чаплыгина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. / Ч. 1: Технологические процессы изготовления кремниевых интегральных схем и их моделирование / М.А.Королев, Т.Ю.Крупкина, М.А.Ревелева. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 397 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 10 экз.).
2. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем: учебное пособие для вузов: в 2 ч. / Под ред. Ю.А. Чаплыгина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. / Ч. 2: Элементы и маршруты изготовления кремниевых ИС и методы их математического моделирования / М.А.Королев [и др.]. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 423 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 35 экз.).
3. Оборудование для создания и исследования свойств объектов наноэлектроники: Учебное пособие / И. А. Чистоедова, Т. И. Данилина - 2011. 98 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/547.

### 7.3. Учебно-методические пособия

#### 7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Данилина Т.И. Технология кремниевой наноэлектроники: Учебно-методическое пособие по лабораторным работам. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. – 68 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://miel.tusur.ru/dwn/umo/id/145791741438/f/TKH_Daninina_Posobie_lab.pdf.
2. Технология кремниевой наноэлектроники: Учебно-методическое пособие по аудиторным практическим занятиям и самостоятельной работе / И. А. Чистоедова, Т. И. Данилина - 2018. 61 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7944.

#### 7.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

**Для лиц с нарушениями зрения:**

– в форме электронного документа;

– в печатной форме увеличенным шрифтом.

**Для лиц с нарушениями слуха:**

Согласована на портале № 60083

– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

**Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

### 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к современным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ: https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.

## 8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

### 8.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с достаточным количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

### 8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Лаборатория физики конденсированного состояния и материалов электронной техники: учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 119 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Лабораторные макеты: «Температурные свойства ферромагнитных материалов», «Температурные свойства проводящих материалов», «Объемное и поверхностное сопротивление изоляционных материалов», «Пробой тонкопленочных конденсаторов (ТПК)», «Температурная зависимость проводимости диэлектриков», «Фотоэлектрические свойства полупроводниковых материалов», «Определение ширины запрещенной зоны полупроводников», «Определение термо-ЭДС полупроводников», «Эффект Холла», «Эффект Пельтье».
- Лабораторное оборудование и приборы: измеритель Е7-8 (2 шт.), вольтметр В7-22А (5 шт.), амперметр Ф-195, М-253 (2 шт.), источник постоянного тока Б5-47, электрометр В7Э-42, мультиметр В7-22А (2 шт.), измеритель иммитанса Е7-20, тераомметр Е6-13, печь лабораторная (2 шт.), прибор для исследования пробоя ТПК, лабораторный стенд СФП-5 (2 шт.), вольтметр В7-26, вольтметр цифровой Ф4214, вольтметр Ф238,

источник постоянного тока Б5-47, измеритель иммитанса Е7-20;

- Компьютерные лабораторные работы (4 шт.);
- Компьютер Intel(R) Core (TM)2 CPU (4 шт.);
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- Free Pascal;
- LibreOffice;
- Microsoft Visual Studio 2010;
- PDF-XChange Viewer;
- PTC Mathcad 13, 14;
- Windows XP;

### 8.3. Материально-техническое и программное обеспечение для лабораторных работ

Учебная аудитория: учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная

Согласована на портале № 60083

аудитория для проведения занятий лабораторного типа; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 124 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Компьютер Intel(R) Core (TM)2 CPU (13 шт.);
- Проектор Benq;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- LibreOffice;
- Microsoft Windows 7;
- PDF-XChange Viewer;
- PascalABC;
- Виртуальная лабораторная работа «Исследование динамических характеристик кантилевера»;
- Виртуальная лабораторная работа «Исследование конструкции и характеристик струнного акселерометра»;
- Виртуальная лабораторная работа «Исследование межэлементной щелевой изоляции в кремниевой наноэлектронике»;
- Виртуальная лабораторная работа «Исследование процессов травления микро- и наноструктур»;
- Виртуальная лабораторная работа «Исследование процессов формирования Т-образного затвора p-HEMT транзистора»;

### 8.4. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду ТУСУРа.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

### 8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями зрения** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.

Согласована на портале № 60083

При занятиях с обучающимися с **нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

## 9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

### 9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы

| Названия разделов (тем) дисциплины | Формируемые компетенции | Формы контроля | Оценочные материалы (ОМ) |
|---|---|---|---|
| 1 Тенденция развития современной кремниевой технологии микро- и наноэлектроники | ПКР-7, ПКС-2 | Контрольная работа | Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ |
| | | Тестирование | Примерный перечень тестовых заданий |
| | | Экзамен | Перечень экзаменационных вопросов |
| 2 Субмикронная фотолитография | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Контрольная работа | Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ |
| | | Тестирование | Примерный перечень тестовых заданий |
| | | Экзамен | Перечень экзаменационных вопросов |
| | | Отчет по практическому занятию (семинару) | Темы практических занятий |
| 3 Пучковые методы литографии | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Контрольная работа | Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ |
| | | Тестирование | Примерный перечень тестовых заданий |
| | | Экзамен | Перечень экзаменационных вопросов |
| | | Отчет по практическому занятию (семинару) | Темы практических занятий |

Согласована на портале № 60083

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 Ионное легирование полупроводников | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Контрольная работа | Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ |
| | | Тестирование | Примерный перечень тестовых заданий |
| | | Экзамен | Перечень экзаменационных вопросов |
| | | Отчет по практическому занятию (семинару) | Темы практических занятий |
| 5 Ионное и плазмохимическое травление микро- и наноструктур | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Контрольная работа | Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ |
| | | Лабораторная работа | Темы лабораторных работ |
| | | Тестирование | Примерный перечень тестовых заданий |
| | | Экзамен | Перечень экзаменационных вопросов |
| | | Отчет по практическому занятию (семинару) | Темы практических занятий |
| 6 Осаждение металлов и диэлектриков. Планаризация рельефа | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Контрольная работа | Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ |
| | | Лабораторная работа | Темы лабораторных работ |
| | | Тестирование | Примерный перечень тестовых заданий |
| | | Экзамен | Перечень экзаменационных вопросов |
| 7 Технологические маршруты изготовления кремниевых ИС | ПКР-7, ПКР-8, ПКС-2 | Контрольная работа | Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ |
| | | Лабораторная работа | Темы лабораторных работ |
| | | Тестирование | Примерный перечень тестовых заданий |
| | | Экзамен | Перечень экзаменационных вопросов |
| | | Отчет по практическому занятию (семинару) | Темы практических занятий |

Шкала оценки сформированности отдельных планируемых результатов обучения по дисциплине приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Шкала оценки сформированности планируемых результатов обучения по

Согласована на портале № 60083

дисциплине

| Оценка | Баллы за ОМ | Формулировка требований к степени сформированности планируемых результатов обучения | | |
|---|---|---|---|---|
| | | знать | уметь | владеть |
| 2 (неудовлетворительно) | < 60% от максимальной суммы баллов | отсутствие знаний или фрагментарные знания | отсутствие умений или частично освоенное умение | отсутствие навыков или фрагментарные применение навыков |
| 3 (удовлетворительно) | от 60% до 69% от максимальной суммы баллов | общие, но не структурированные знания | в целом успешно, но не систематически осуществляемое умение | в целом успешное, но не систематическое применение навыков |
| 4 (хорошо) | от 70% до 89% от максимальной суммы баллов | сформированные, но содержащие отдельные проблемы знания | в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение | в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы применение навыков |
| 5 (отлично) | ≥ 90% от максимальной суммы баллов | сформированные систематические знания | сформированное умение | успешное и систематическое применение навыков |

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

| Оценка | Формулировка требований к степени компетенции |
|---|---|
| 2 (неудовлетворительно) | Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале<br>или<br>Знать на уровне **ориентирования**, представлений. Обучающийся знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. |
| 3 (удовлетворительно) | Знать и уметь на **репродуктивном** уровне. Обучающихся знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. |
| 4 (хорошо) | Знать, уметь, владеть на **аналитическом** уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения. |
| 5 (отлично) | Знать, уметь, владеть на **системном** уровне. Обучающийся знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания дисциплины, его значимость в содержании дисциплины. |

Согласована на портале № 60083

### 9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

1. Что представляет собой проецированный пробег ионов в твердом теле?
   а) полный путь иона;
   б) проекция полного пути на направление первоначального движения иона (направление x);
   в) проекция пути на направление y;
   г) боковое рассеяния.
2. Глубина залегания p-n перехода с увеличением дозы облучения:
   а) не изменяется; б) возрастает; в) уменьшается г) сначала уменьшается, затем увеличивается.
3. Глубина залегания p-n перехода с увеличением энергии ионов:
   а) не изменяется; б) возрастает; в) сначала увеличивается, затем уменьшается ; г) уменьшается.
4. При низкотемпературном отжиге радиационных дефектов глубина залегания p-n перехода:
   а) не изменяется; б) увеличивается; в) уменьшается; г). сначала уменьшается, затем увеличивается.
5. Сферическая аберрация обусловлена:
   а) действием фокусирующего поля линзы; б) разбросом скоростей электронов; в) дифракцией; г) температурой подложки
6. Хроматическая аберрация обусловлена:
   а) действием фокусирующего поля линз; б) разбросом скоростей электронов; в) дифракцией; г) температурой подложки
7. Для идеального изотропного травления показатель анизотропии:
   а) равен 1; б) больше 1; в) меньше 1; г) равен 100.
8. Плазмохимическое травление является результатом…
   а) физического распыления в условиях газового разряда ионами инертных газов;
   б) травления ХАЧ в условиях воздействия плазмы;
   в) физического распыления ионами инертных газов в условиях высокого вакуума;
   г) физического распыления ионами инертного газа в плазме.
9. Почему разрешающая способность электронно-лучевой литографии выше, чем оптической фотолитографии?
   а) энергия электронов меньше, чем энергия фотонов;
   б) длина волны излучения для ускоренных электронов меньше, чем длина волны УФ-излучения;
   в) длина волны для ускоренных электронов больше, чем длина волны УФ-излучения;
   г) энергия электронов больше, чем энергия фотонов.
10. Указать причину, по которой для ионной имплантации бора используют тяжелые молекулы, содержащие бор…
    а) увеличение энергии ионов бора; б) увеличение xp-n; в) уменьшение xp-n; г) уменьшение энергии ионов бора.

Согласована на портале № 60083

### 9.1.2. Перечень экзаменационных вопросов

1. Области применения имплантации
2. Чем определяется время экспонирования при электронно-лучевой литографии?
3. Субмикронная фотолитография
4. Модель ПХТ. Влияние температуры подложки на процесс травления
5. Каналирование ионов
6. Синтез материалов с помощью ионной имплантации (оксиды, силициды)
7. Разрешающая способность электронно-лучевой литографии
8. Сухое травление: плазменное (ПХИ и РИД) и ионно-пучковое травление. Типы и особенности процессов
9. Пробеги ионов в твердых телах
10. Электронно-оптическая система ЭЛУ
11. Субмикронная проекционная фотолитография
12. Механизмы энергетических потерь при ионном легировании
13. Механизмы ионного травления. Параметры
14. Технология формирования структур «кремний на изоляторе» с помощью ионной имплантации
15. Формирование электронных лучей субмикронных размеров
16. Чем определяется длина волны экспонирующего излучения в электронно-лучевой литографии?
17. Влияние поперечной составляющей тепловой скорости электронов на разрешающую способность электронной литографии
18. Радиационные дефекты. Образование аморфной фазы. Использование радиационных дефектов на практике
19. Быстрый термический отжиг. Области применения
20. Характеристики методов травления (жидкостное, ионное, плазмохимическое)
21. Распределение внедренной примеси по глубине при ионной имплантации. Образование p-n перехода
22. Методы импульсного отжига
23. Взаимодействие электронов с резистом. Энергетические потери. Рассеяние электронов
24. Способы формирования супермелкозалегающих p-n переходов
25. Чему равна селективность травления, если скорость травления фоторезиста в два раза больше скорости травления подложки?

### 9.1.3. Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ

1. Вариант 1
   1. Как получается рисунок при последовательной ЭЛЛ.
   2. Каким образом для электронной пушки обеспечить малое значение угла схождения a (для уменьшения аберраций) при достаточной Imax? Рассмотреть этот вопрос теоретически и практически.
   3. Представить механизмы рассеяния пучка электронов при электронно-лучевом экспонировании.

2. Вариант 2
   1. Показать на рисунке возникновение сферической аберрации в ЭЛУ.
   2. Как изменится ток на образец при уменьшении диаметра электронного пятна с 10 до 0,1 мкм, если при диаметре пятна 10 мкм ток оставляет 10-5 А?
   3. Рассмотреть причины возникновения разброса энергий электронов в электронном луче. Каким образом разброс энергий электронов ограничивает минимальный размер пятна

Согласована на портале № 60083

электронного луча на мишени?

3. Вариант 3
   1. Показать на рисунке угол сходимости и положение кроссовера в электронно-лучевой установке.
   2. Изменение эффективных энергетических потерь оп глубине. Показать положение характерных точек.
   3. Позитивный и негативный эффекты при электронно-лучевом экспонировании.

4. Вариант 4
   1. Определить параметры, которые будут определять время ионной имплантации?
   2. Объяснить характер распределения примеси при ионной имплантации.
   3. Что такое точечные дефекты? Рассчитать концентрацию этих дефектов при бомбардировке мишени из кремния ионами бора с дозой 10^13 см^-2. Есм=15 эВ. Ядерные потери составляют 16 кэВ/мкм.

5. Вариант 5
   1. Что такое доза облучения?
   2. Зачем используется имплантация ионов бора различных масс?
   3. Представить профили концентрации акцепторной примеси, введенной имплантацией в полупроводник с исходной концентрацией N=const, при создании p-n перехода ионами низкой энергии; n-p-n структуры ионами высокой энергии, p-n перехода с постоянной концентрацией примеси в легированной области ионами разных энергий.

6. Вариант 6
   1. Дать понятие полного и проецированного пробегов.
   2. Способы управления xp-n при ионной имплантации.
   3. Технология загонки примеси при ионной имплантации. На что влияет боковое рассеяние ионов?

### 9.1.4. Темы практических занятий

1. Субмикронная фотолитография
2. Электронно-лучевая литография
3. Ионная имплантация в технологии СБИС
4. Ионно-лучевое травление микро- и наноструктур
5. Маршрут изготовления СБИС

### 9.1.5. Темы лабораторных работ

1. Исследование процессов травления микро- и наноструктур
2. Исследование межэлементной щелевой изоляции в кремниевой наноэлектронике
3. Исследование процессов формирования Т-образного затвора p-HEMT транзистора
4. Методы формирования микро- и наноструктур

## 9.2. Методические рекомендации

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими

Согласована на портале № 60083

научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:

– чтение или просмотр материала осуществляйте со скоростью, достаточной для индивидуального понимания и освоения материала, выделяя основные идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из практики;

– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;

– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.

Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств телекоммуникации.

По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия, в т.ч. в форме вебинаров. Расписание вебинаров и записи вебинаров публикуются в электронном курсе / электронном журнале по дисциплине.

### 9.3. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

| Категории обучающихся | Виды дополнительных оценочных материалов | Формы контроля и оценки результатов обучения |
|---|---|---|
| С нарушениями слуха | Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы | Преимущественно письменная проверка |
| С нарушениями зрения | Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам | Преимущественно устная проверка (индивидуально) |
| С нарушениями опорно-двигательного аппарата | Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету | Преимущественно дистанционными методами |
| С ограничениями по общемедицинским показаниям | Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы | Преимущественно проверка методами, определяющимися исходя из состояния обучающегося на момент проверки |

### 9.4. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной форме;

– в печатной форме с увеличенным шрифтом;

– в форме электронного документа;

– методом чтения ассистентом задания вслух;

– предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

– письменно на бумаге;

– набор ответов на компьютере;

– набор ответов с использованием услуг ассистента;

Согласована на портале № 60083

– представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

**Для лиц с нарушениями зрения:**

– в форме электронного документа;

– в печатной форме увеличенным шрифтом.

**Для лиц с нарушениями слуха:**

– в форме электронного документа;

– в печатной форме.

**Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

– в форме электронного документа;

– в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Согласована на портале № 60083

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ФЭ
протокол № 97 от «15» 11 2018 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

| Должность | Инициалы, фамилия | Подпись |
|---|---|---|
| Заведующий выпускающей каф. ФЭ | П.Е. Троян | Согласовано, 1c6cfa0a-52a6-4f49-aef0-5584d3fd4820 |
| Заведующий обеспечивающей каф. ФЭ | П.Е. Троян | Согласовано, 1c6cfa0a-52a6-4f49-aef0-5584d3fd4820 |
| Начальник учебного управления | Е.В. Саврук | Согласовано, fa63922b-1fce-4a6a-845d-9ce7670b004c |

**ЭКСПЕРТЫ:**

| | | |
|---|---|---|
| Старший преподаватель, каф. ФЭ | В.В. Каранский | Согласовано, c2e55ae8-0332-4ed9-a65a-afbb92539ee8 |
| Заведующий кафедрой, каф. ФЭ | П.Е. Троян | Согласовано, 1c6cfa0a-52a6-4f49-aef0-5584d3fd4820 |

**РАЗРАБОТАНО:**

| | | |
|---|---|---|
| Доцент, каф. ФЭ | И.А. Чистоедова | Разработано, 2114f42c-7cf2-4826-9f35-9a75ea4961b2 |

Согласована на портале № 60083